

(19) Korea patent office (KR) Unexamined Patent
Publication (A)

(51) Int.Cl. 6 H01L 21/31

Registration No	KR2002-0032054.
Application No	10-2000-0062930
Application Date	25/10/2000
Publication Date	03/05/2002
Agent	SHINSUNG PATENT FIRM
Inventor	Heung-Jae Cho
	Chan Im
	Dae-Gyu Park
Applicant	Hynix Semiconductor Inc. Jong-Seop Park
Examination	EopEum
Title of Invention	The method for forming silicate [Method for forming silicate by using atomic layer deposition] using the atomic layer deposition.

* Legal Status

Date of request for an examination	20050929
Notification date of refusal decision	00000000
Final disposal of an application	registration
Date of final disposal of an application	20070129
Patent registration number	1006937810000
Date of registration	20070306
Number of opposition against the grant of a patent	
Date of opposition against the grant of a patent	00000000
Number of trial against decision to refuse	
Date of requesting trial against decision to refuse	
Date of extinction of right	



Abstract

The present invention relates to the method for forming silicate it can improve the interfacial property of a silicate and silicon substrate and it prevent the GOI characteristic degradation according to that, and for obtaining the step coverage property of being excellent. In the embodiment of the present invention, a source including H₂O, O, Si etc. is gradually, by stages injected and the Hf silicate is formed into the method for atomic layer deposition. The method for performing a sequential heat treatment in order to improve the membranous property of the

Hf silicate is shown.



Representative Drawing(s)

Fig. 2d



Keyword(s)

The silicate, atomic layer deposition, hf, thermal process.



Description

■ Brief Explanation of the Drawing(s)

Figure 1 is a structure chart of the zirconium silicate which the Hf silicate type processing sectional view, and fig. 3 have the structure of being similar to the Hf silicate according to the cross-sectional view showing the structure of the reaction chamber used for the silicate formation process of the present invention, and the figs. 2a through 2d is the embodiment of the present invention.

■ Details of the Invention

■ Purpose of the Invention

■ The Technical Field to which the Invention belongs and the Prior Art in that Field

The present invention relates to the semiconductor element manufacture field, particularly, to the method of forming a gate dielectric layer of the MOS transistor.

In the integrated of the semiconductor device, the thickness of the gate insulating layer ***s to an improvement. Because the leakage current is enlarged with the direct tunneling through the gate insulating layer if the gate insulating layer ***s, the gate insulating layer is formed into the material in which recently the dielectric constant is high. That is, many research about the method for reducing the leakage current by increasing the effective thickness of the gate insulating layer, proceeds. And the method for forming the Hf oxide film (HfO₂) or the Hf silicate on the silicon substrate is suggested as the representative example.

As to HfO₂, the threshold voltage of the transistor which is formed on the wafer in which the dielectric constant is changed according to the crystallographic orientation because of being crystallized at the low temperature is not fixed. Moreover, there is a problem that in the increment of the leakage current, and a deterioration and source of GOI it has the grain boundary, the phenomenon that becomes with the congestion (crowding) announces in the electric charge grain boundary moving towards a drain and in conclusion, an affect is given to the working speed of a device during.

On the contrary, as to the Hf silicate, the dielectric constant is lower than HfO₂. However, because of remaining as the amorphous structure of being stabilized in the high temperature, it can overcome the problem that the Hf oxide film has. That is, the Hf silicate is no need to form the separate interlayer film stable and which can have the interfacial property of being stable with Si and considering the interfacial property than HfO₂. It can form the

gate electrode into the doped polysilicon on the Hf silicate and it like that can use the conventional semiconductor process.

The conventional Hf silicate forms by using the physical vapor deposition. That is, Hf and Si each target are sputtered, or Hf and Si the sputtering (co-sputtering) and oxidation process are together performed and the Hf silicate is formed on the silicon substrate.

As to this conventional Hf method for forming silicate, because of using the method of physical vapor deposition, a silicate elementarily, primarily gets the plasma corruption (plasma damage) and the interfacial property of the Hf silicate and silicon substrate interface becomes bad and a problem is generated in the component performance. The trap charge (trapped charge) is generated within the Hf silicate and the problem that the GOI (gate oxide integrity) characteristic is degraded is generated. Moreover, the method of physical vapor deposition has the disadvantage that the thickness of the silicate which is evaporated in the element isolation region and active area because the step coverage characteristic is bad is respectively different and the GOI characteristic is lowered.

■ The Technical Challenges of the Invention

The problem as described above is solved. And it are an object of the present invention to provide the method for forming silicate it can improve the interfacial property of a silicate and silicon substrate and it prevent the GOI characteristic degradation according to that, and for obtaining the step coverage property of being excellent.

■ Structure & Operation of the Invention

The purpose as described above is achieved. And the present invention is to provide the method for forming silicate for alternately injecting the first element, and the oxygen and silicon each source as to the method for forming silicate for being made of the first element, and the oxygen and silicon within the reaction chamber and forming a silicate into the atomic layer deposition on a wafer.

Moreover, a purpose is accomplished. And the present invention is to provide the method for forming silicate for including the fourth stage forming the silicate consisting of the first step injecting a wafer within the reaction chamber, the second step injecting the first source, the third step injecting the second source, and the first element, and the compound of the silicon and oxygen the third source as to the method for forming silicate for being made of the first element, and the oxygen and silicon. As to the second step, the first element is included within the reaction chamber and deposits the first atomic layer by the atomic layer deposition on a wafer. As to the third step, the oxygen is included within the reaction chamber and forms the compound layer of the oxygen and the first element. As to the first element, and the compound of the silicon and oxygen the third source, the silicon is included is injected within the reaction chamber.

In the embodiment of the present invention, a source including H₂O, O, Si etc. is gradually, by stages injected and the stable Hf silicate is formed into the atomic layer deposition method. The method for performing a sequential heat treatment in order to improve the membranous property of the Hf silicate is shown.

According to below, and the embodiment of the present invention, concretely it illustrates for the method for forming the Hf silicate on the silicon substrate dividing each domain from the element isolation film into the atomic layer deposition by the surface saturation mechanism.

As shown in Figure 1, the third source paths (101, 102, 103) through the first wears around the third source paths (101, 102, 103) through the first to the respective hotwires (heating line, 104) and it is wrapped. The silicon wafer (10) is mounted within the chamber (100) in which the reactive part (reaction part) is heated by thermal plates (heating block, 105). In fig. 1, the diagram symbol '200' shows the vacuum processing device, connected to the chamber that is, the pump etc.

Subsequently, as shown in it is seen in the drawing 2a, the Hf source including HfCl_4 or the hafnium tetra – butoxide ($\text{Hf}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$) etc. is put into 10 sccm or 10 slm extent reaction chamber (100). Hf is evaporated on the silicon wafer (10).

Subsequently, in order that the Hf source which does not react to the silicon wafer (10) and remains within the reaction chamber (100) is removed, the inactive gas of 10 sccm or 10 slm is injected within the reaction chamber (100) and the Hf source is discharged with the inactive gas from the reaction chamber (100).

Next, as shown in Figure 2b, H_2O or O_3 is injected within the reaction chamber (100) or O_2 or the O_3 excited to the ultraviolet ray (UV) is injected with 10 sccm or about 10 slm and it reacts with the Hf already evaporated on the silicon wafer (10) and HfO_2 is formed.

Subsequently, the inactive gas of 10 sccm or 10 slm is injected within the reaction chamber (100). O_2 or the excited O_3 is discharged to H_2O or the O_3 which does not react to the silicon wafer (10) and remains within the reaction chamber (100), and the ultraviolet ray with the inactive gas from the reaction chamber (100).

Next, as shown in it is seen in the drawing 2c, the silicone compound including SiH_4 , Si_2H_6 or the SiCl_2H_2 etc. is injected into 10 sccm or 10 slm extent reaction chamber (100) and HfO_2 and the Si already formed on the silicon wafer (10) are bound and the Hf silicate (HfSi_xO_y) is formed.

Subsequently, the inactive gas of 10 sccm or 10 slm is injected within the reaction chamber (100). The SiH_4 , which does not react to the silicon wafer (10) and remains within the reaction chamber (100) Si_2H_6 or SiCl_2H_2 etc. are discharged with the inactive gas from the reaction chamber (100).

Series of process to an exhaustion including the SiH_4 in the Hf injection, Si_2H_6 or SiCl_2H_2 etc are repetitively performed and the Hf silicate layer of the constant thickness is formed.

Next, as shown in it is seen in the drawing 2d, the thermal process for the densification of the Hf silicate layer is performed. At this time, the method for doing for about half an hour with the rapid thermal processing (rapid thermal process) or the furnace annealing (furnace) and heat–treating the Hf silicate at 500 °C or 1000 °C temperature in the method, for exciting O_2 or O_3 and heat–treating the Hf silicate layer in 300 °C or 500 °C temperature by taking advantage of the ultraviolet ray N_2O , and O_2 or the inert gas atmosphere can be used.

The Hf injection, the oxygen implanting, and the Si source implant step differentiate the order and it injects within the chamber and it can form the Hf silicate. In the meantime, the Hf silicate formation process progresses in the reaction chamber maintained by 200 °C or 800 °C temperature.

The subsequent processes of the etc. depositing the polysilicon layer or the metal layer etc. on a next, and the Hf silicate which as described above, is formed and performs the patterning process and forms the gate electrode of a transistor is progressed.

In the preferred embodiment of the present invention described in the above, the Hf method for forming silicate was explained. However, by using the Zr source like the ZrCl_4 , Zr tetra – buta oxide ($\text{Zr}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$), TaCl_5 , the Ta N thoxy ($\text{Ta}(\text{OC}_2\text{H}_5)_5$), LaCl_3 etc or the La source in order to form the zirconium silicate or the La silicate etc. instead of Hf, the various silicate in which the dielectric constant is high can be formed.

As described above, as to the present invention, by not using the method of physical vapor deposition and forming the Hf silicate it can prevent the damage according to the physical vapor deposition. Moreover, the Hf silicate having the composition which desires by appropriately controlling a dose including the SiH_4 , which is the Si source Si_2H_6 or SiCl_2H_2 etc., can be formed.

Figure 3 is a structure chart of the zirconium silicate (ZrSiO_4) having the structure of being similar to the Hf silicate (HfSiO_4). It has the advantage which can form the silicate of the amorphous while controlling the dielectric constant by appropriately controlling amount of Si like the present invention in forming the Hf silicate (HfSiO_4) in which the Hf silicate Hf and Si form O atom and bonding of the respective 4 as the structure where HfO_2 and SiO_2 are periodically connected like the zirconium silicate in each chain and having three dimensional structure. Moreover, the reliability of the gate insulating layer can be improved according to use the method for

atomic layer deposition with a superior step coverage property.

In the above, the present invention illustrated is not restricted by the above-described embodiment and the attached drawing, but it has to a person skilled in the art and it will be clear in the technical field in which the present invention belongs to be possible in the range that does not depart from the technical mapping of the present invention with many substitution, and the deformation and change like.

■ Effects of the Invention

As described above, the present invention can prevent the preventing damage according to the physical vapor deposition by forming the Hf silicate into the method for atomic layer deposition. According to that, the gate insulating layer using the Hf silicate which has the high dielectric constant while the reliability is high and it is stable can be formed.



Scope of Claims

Claim 1 :

The method for forming silicate for alternately injecting the first element, and the oxygen and silicon each source as to the method for forming silicate for being made of first element, and the oxygen and silicon within the reaction chamber and forming a silicate into the atomic layer deposition on a wafer.

Claim 2 :

The method for forming silicate of the method for forming silicate for being made of the first element, and the oxygen and silicon comprising: the fourth stage forming the silicate consisting of the first step injecting a wafer within the reaction chamber, the second step injecting the first source, the third step injecting the second source, and the first element, and the compound of the silicon and oxygen the third source; as to the second step, the first element is included within the reaction chamber and deposits the first atomic layer by the atomic layer deposition on a wafer; as to the third step, the oxygen is included within the reaction chamber and forms the compound layer of the oxygen and the first element; and as to the first element, and the compound of the silicon and oxygen the third source, the silicon is included is injected within the reaction chamber.

Claim 3 :

The method for forming silicate of claim 2, further comprising the seventh step which more includes the fifth step injecting the inactive gas within the reaction chamber and discharges the first source remaining behind within the reaction chamber with the inactive gas from the reaction chamber after the second step; it more includes the sixth step injecting the inactive gas within the reaction chamber and discharges the second source remaining behind within the reaction chamber with the inactive gas from the reaction chamber after the third step; and it injects the inactive gas after the fourth stage within the reaction chamber and discharges the third source remaining behind within the reaction chamber with the inactive gas from the reaction chamber.

Claim 4 :

The method for forming silicate of claim 3, further comprising the eighth step which once more performs the second step or a series of process of being made of the seventh step after the seventh step at least.

Claim 5 :

The method for forming silicate of claim 4, further comprising the ninth step heat-treating a silicate after the eighth step.

Claim 6 :

The first element as to any one of claims 2 through 5.

The method for forming silicate wherein it is one among Hf, and Zr or La.

Claim 7 :

The first source as to claim 6.

The method for forming silicate wherein it is one among the HfCl_4 , the hafnium tetra - butoxide ($\text{Hf}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$), the ZrCl_4 , Zr tetra - buta oxide ($\text{Zr}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$), TaCl_5 , the Ta N thoxy ($\text{Ta}(\text{OC}_2\text{H}_5)_5$) or LaCl_3 .

Claim 8 :

The method for forming silicate of any one of claims 2 through 5, wherein in the second step, HfCl_4 or the hafnium tetra - butoxide ($\text{Hf}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$) is injected and the Hf layer is formed on a wafer; O_2 or the O_3 excited to H_2O or O_3 , and the ultraviolet ray in the third step is injected and it forms on a wafer with the HfO_2 layer; and SiH_4 , and Si_2H_6 or SiCl_2H_2 are injected in the fourth stage and the Hf silicate layer is formed on a wafer.

Claim 9 :

As to claim 8, by taking advantage of the ultraviolet ray, it excites O_2 or O_3 and the ninth step heat-treats a silicate in 300 °C or 500 °C temperature.

The method for forming silicate wherein in N_2O , and O_2 or the inert gas atmosphere, it heat-treats at 500 °C or 1000 °C temperature with the rapid thermal processing or the furnace.



Drawings

Fig. 1

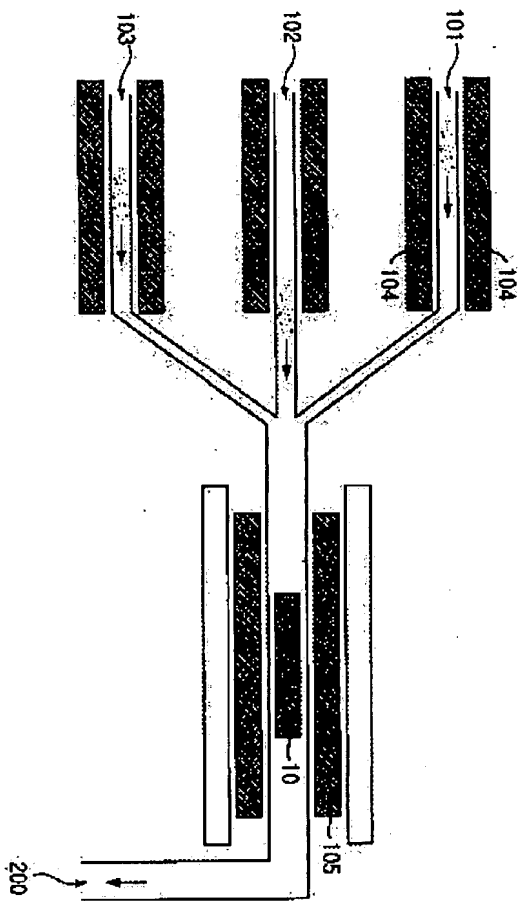


Fig. 2a

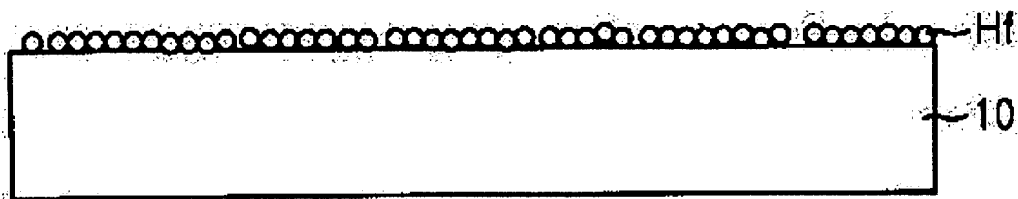


Fig. 2b



Fig. 2c

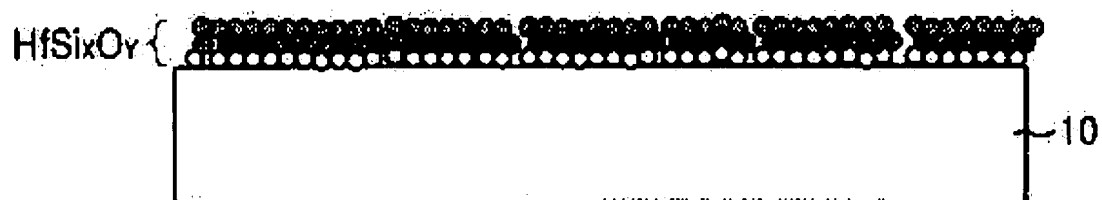


Fig. 2d

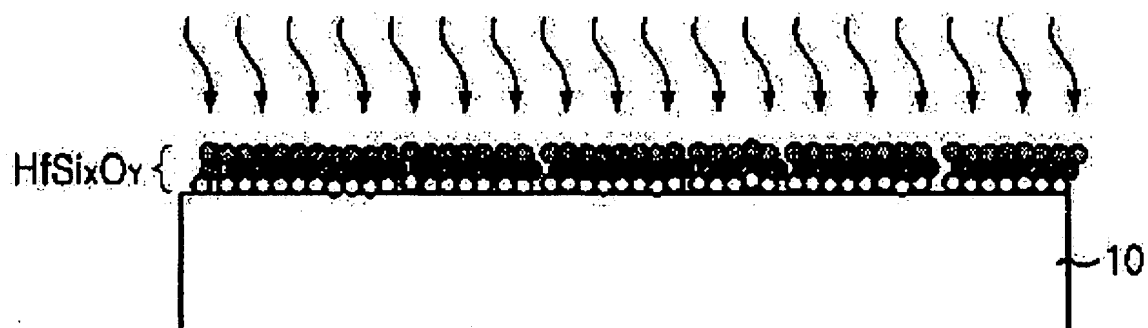


Fig. 3

(19) 대한민국특허청 (KR)
(12) 공개특허공보 (A)

(51) 。 Int. Cl. 7
H01L 21/31

(11) 공개번호 특2002 - 0032054
(43) 공개일자 2002년05월03일

(21) 출원번호 10 - 2000 - 0062930
(22) 출원일자 2000년10월25일

(71) 출원인 주식회사 하이닉스반도체
박종섭
경기 이천시 부발읍 아미리 산136 - 1

(72) 발명자 조홍재
경기도의왕시오전동849번지동백아파트103 - 1003
임찬
경기도이천시대월면사동리현대5차아파트502 - 1702
박대규
경기도이천시부발읍신하리481 - 1삼익아파트104 - 904

(74) 대리인 특허법인 신성

심사청구 : 없음

(54) 단원자층 증착법을 이용한 실리케이트 형성 방법

요약

본 발명은 실리콘 기판과 실리케이트의 계면 특성을 향상시킬 수 있고 그에 따라 GOI 특성 저하를 방지할 수 있으며, 양호한 단차 피복 특성을 얻을 수 있는 실리케이트 형성 방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에서는 H₂O, O, Si 등의 소스를 단계적으로 주입하여 단원자층 증착 방법으로 Hf 실리케이트를 형성하고, Hf 실리케이트의 막질 특성을 향상시키기 위하여 후속 열처리하는 방법을 제시한다.

대표도
도 2d

색인어
실리케이트, 단원자층 증착, Hf, 열처리

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실리케이트 형성 공정에 이용되는 반응 챔버의 구조를 개략적으로 보이는 단면도,

도 2a 내지 도 2d는 본 발명의 실시예에 따른 Hf 실리케이트 형성 공정 단면도,

도 3은 Hf 실리케이트와 유사한 구조를 갖는 Zr 실리케이트의 구조도.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 소자 제조 분야에 관한 것으로, 특히 MOS 트랜지스터의 게이트 절연막 형성 방법에 관한 것이다.

반도체 소자의 집적도 향상으로 게이트 절연막의 두께가 얇아진다. 게이트 절연막이 얇아지면 게이트 절연막을 통한 직접 터널링(direct tunneling)에 의해 누설전류가 커지기 때문에 최근에는 유전율이 높은 물질로 게이트 절연막을 형성한다. 즉, 게이트 절연막의 유효 두께를 증가시킴으로써 누설전류를 감소시키는 방법에 대한 많은 연구가 진행되고 있으며, 그 대표적인 예로써 실리콘 기판 상에 Hf 산화막(HfO_2) 또는 Hf 실리케이트를 형성하는 방법이 제시되고 있다.

HfO_2 는 낮은 온도에서 결정화되기 때문에 결정방위에 따라 유전율이 달라져 한 웨이퍼 상에 형성되는 트랜지스터의 문턱전압이 일정하지 않다. 또한 결정립계를 갖게 됨에 따른 누설전류의 증가, GOI의 열화 및 소스에서 드레인 쪽으로 이동하는 전하들이 결정립계에서 밀집(crowding)되는 현상이 발생하여 결국 소자의 동작 속도에 영향을 주는 문제점이 있다.

이에 반하여 Hf 실리케이트는 HfO_2 보다 유전율은 낮지만, 높은 온도에서도 안정된 비정질 구조로 남아있기 때문에 Hf 산화막이 갖는 문제점을 극복할 수 있다. 즉, Hf 실리케이트는 HfO_2 보다 열역학적으로 안정하여 Si와 안정한 계면 특성을 가질 수 있어 계면특성을 고려한 별도의 층간막(interlayer)을 형성할 필요가 없고, Hf 실리케이트 상에 도핑된 폴리실리콘으로 게이트 전극을 형성할 수 있어 종래 반도체 공정을 그대로 이용할 수 있다.

종래 Hf 실리케이트는 물리기상증착법(physical vapor deposition)을 이용하여 형성한다. 즉, Hf과 Si 각각의 타겟(target)을 스퍼터링하거나, Hf과 Si를 함께 스퍼터링(co-sputtering)하고 산화공정을 실시하여 실리콘 기판 상에 Hf 실리케이트를 형성한다.

이러한 종래의 Hf 실리케이트 형성 방법은 물리기상증착방법을 이용하기 때문에 실리케이트가 기본적으로 플라스마 손상(plasma damage)을 입게되어 실리콘 기판 계면과 Hf 실리케이트의 계면 특성이 나빠져 소자 동작에 문제가 발생하고, Hf 실리케이트 내에 포획전하(trapped charge)가 발생하여 GOI(gate oxide integrity) 특성이 열화되는 문제점이 발생한다. 또한 물리기상증착 방법은 단차 피복(step coverage) 특성이 나쁘기 때문에 소자분리 영역과 활성영역에 증착되는 실리케이트의 두께가 각기 달라서 GOI 특성이 크게 저하되는 단점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 실리콘 기판과 실리케이트의 계면 특성을 향상시킬 수 있고 그에 따라 GOI 특성 저하를 방지할 수 있으며, 양호한 단차 피복 특성을 얻을 수 있는 실리케이트 형성 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 제1 원소, 산소 및 실리콘으로 이루어지는 실리케이트 형성 방법에 있어서, 반응챔버 내에 상기 제1 원소, 산소 및 실리콘 각각의 소스를 번갈아 주입하여 단원자층 증착법으로 웨이퍼 상에 실리케이트를 형성하는 실리케이트 형성 방법을 제공한다.

또한 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 제1 원소, 산소 및 실리콘으로 이루어지는 실리케이트 형성 방법에 있어서, 반응챔버 내에 웨이퍼를 주입하는 제1 단계; 상기 반응챔버 내에 제1 원소가 포함된 제1 소스를 주입하여 단원자층 증착법으로 상기 웨이퍼 상에 제1 원소층을 증착하는 제2 단계; 상기 반응챔버 내에 산소가 포함된 제2 소스를 주입하여 제1 원소와 산소의 화합물층을 형성하는 제3 단계; 및 상기 반응챔버 내에 실리콘이 포함된 제3 소스를 주입하여 제1 원소, 산소 및 실리콘의 화합물로 이루어지는 실리케이트를 형성하는 제4 단계를 포함하는 실리케이트 형성 방법을 제공한다.

본 발명의 실시예에서는 H_2O , O , Si 등의 소스를 단계적으로 주입하여 단원자층 증착(atomic layer deposition) 방법으로 안정한 Hf 실리케이트를 형성하고, Hf 실리케이트의 막질 특성을 향상시키기 위하여 후속 열처리하는 방법을 제시한다.

이하, 본 발명의 실시예에 따라 소자분리막으로 각각의 영역이 분리된 실리콘 기판에 표면 포화 원리(surface saturation mechanism)에 의한 단원자층 증착법으로 Hf 실리케이트를 형성하는 방법에 대해 상세하게 설명한다.

도 1과 같이 제1 내지 제3의 소스 통로(101, 102, 103)가 각각 열선(heating line, 104)으로 둘러 싸이고, 반응부(reaction part)가 열판(heating block, 105)에 의해 가열되는 챔버(100) 내에 실리콘 웨이퍼(10)를 장착한다. 도 1에서 도면부호 '200'은 챔버에 연결된 진공처리 장치, 즉 펌프(pump) 등을 나타낸다.

이어서 도 2a에 보이는 바와 같이, $HfCl_4$ 또는 하프늄 테트라-부토사이드($Hf(OC_4H_9)_4$) 등의 Hf 소스를 10 sccm 내지 10 slm 정도 반응 챔버(100)에 넣어, 실리콘 웨이퍼(10) 상에 Hf를 증착시킨다.

이어서, 실리콘 웨이퍼(10)와 반응하지 않고 반응 챔버(100)내에 남아 있는 Hf 소스를 제거하기 위해, 반응챔버(100) 내에 10 sccm 내지 10 slm의 불활성 가스를 주입하여 불활성 가스와 함께 Hf 소스를 반응챔버(100) 밖으로 배출시킨다.

다음으로 도 2b에 도시한 바와 같이, H_2O 또는 O_3 를 반응챔버(100) 내에 주입하거나 자외선(UV)으로 여기된 O_2 또는 O_3 를 10 sccm 내지 10 slm 정도 주입하여 실리콘 웨이퍼(10) 상에 이미 증착되어있던 Hf와 반응시켜 HfO_2 를 형성한다.

이어서, 반응챔버(100) 내에 10 sccm 내지 10 slm의 불활성 가스를 주입하여, 실리콘 웨이퍼(10)와 반응하지 않고 반응챔버(100)내에 남아 있는 H_2O 또는 O_3 , 자외선으로 여기된 O_2 또는 O_3 를 불활성 가스와 함께 반응챔버(100) 밖으로 배출시킨다.

다음으로 도 2c에 보이는 바와 같이, SiH_4 , Si_2H_6 또는 $SiCl_2H_2$ 등과 같은 실리콘 화합물을 10 sccm 내지 10 slm 정도 반응챔버(100)에 주입하여 실리콘 웨이퍼(10) 상에 이미 형성되었던 HfO_2 와 Si를 결합시켜 Hf 실리케이트($HfSi_xO_y$)를 형성한다.

이어서, 반응챔버(100) 내에 10 sccm 내지 10 slm의 불활성 가스를 주입하여, 실리콘 웨이퍼(10)와 반응하지 않고 반응챔버(100)내에 남아 있는 SiH_4 , Si_2H_6 또는 $SiCl_2H_2$ 등을 불활성 가스와 함께 반응챔버(100) 밖으로 배출시킨다.

Hf 주입에서 SiH_4 , Si_2H_6 또는 $SiCl_2H_2$ 등의 배출에 이르는 일련의 과정을 반복적으로 실시하여 일정 두께의 Hf 실리케이트층을 형성한다.

다음으로 도 2d에 보이는 바와 같이, Hf 실리케이트층의 치밀화를 위한 열처리를 실시한다. 이때, 자외선을 이용하여 300 °C 내지 500 °C 온도에서 O₂ 또는 O₃를 여기시켜 Hf 실리케이트층을 열처리하는 방법, N₂O, O₂ 또는 불활성 가스 분위기에서 500 °C 내지 1000 °C 온도로 약 30분 동안 급속열처리(rapid thermal process) 또는 퍼니스 열처리(furnace)하여 Hf 실리케이트를 열처리하는 방법을 이용할 수 있다.

상기 Hf 주입, 산소 주입, Si 소스 주입 단계는 그 순서를 달리하여 챔버내에 주입하여 Hf 실리케이트를 형성할 수도 있다. 한편, 상기 Hf 실리케이트 형성 공정은 200 °C 내지 800 °C 온도로 유지된 반응챔버 내에서 진행한다.

이후, 상기와 같이 형성된 Hf 실리케이트 상에 폴리실리콘막 또는 금속막 등을 증착하고 패터닝 공정을 실시하여 트랜지스터의 게이트 전극을 형성하는 등의 후속 공정을 진행한다.

전술한 본 발명의 실시예에서는 Hf 실리케이트 형성 방법을 설명하였지만, Hf를 대신하여 Zr 실리케이트 또는 La 실리케이트 등을 형성하기 위해 ZrCl₄, Zr 테트라 - 부타옥사이드(Zr(OC₄H₉)₄), TaCl₅, Ta 엔톡시(Ta(OC₂H₅)₅), La Cl₃ 등과 같은 Zr 소스 또는 La 소스를 이용하여 유전율이 높은 다양한 실리케이트를 형성할 수도 있다.

상기와 같이 이루어지는 본 발명은 물리기상증착 방법을 이용하지 않고 Hf 실리케이트를 형성함으로써 물리기상증착에 따른 손상을 방지할 수 있다. 또한, Si 소스인 SiH₄, Si₂H₆ 또는 SiCl₂H₂ 등의 주입량을 적절히 조절함으로써 원하는 조성을 갖는 Hf 실리케이트를 형성할 수 있다.

도 3은 Hf 실리케이트(ZrSiO₄)와 유사한 구조를 갖는 Zr 실리케이트(ZrSiO₄)의 구조도이다. Hf 실리케이트도 Zr 실리케이트와 마찬가지로 HfO₂와 SiO₂가 주기적으로 연결되어 있는 구조로서 각각의 체인(chain) 안에 Hf과 Si이 각각 4개의 O 원자와 본딩(bonding)을 형성하여 3차원 구조를 갖는 Hf 실리케이트(HfSiO₄)를 형성함에 있어 본 발명과 같이 Si의 양을 적절히 조절함으로써 유전율도 조절할 수 있으며 비정질의 실리케이트를 형성할 수 있는 이점이 있다. 또한, 단차 피복 특성이 우수한 단원자층 증착 방법을 사용함에 따라 게이트 절연막의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.

이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.

발명의 효과

상기와 같이 이루어지는 본 발명은 단원자층 증착 방법으로 Hf 실리케이트를 형성함으로써 물리기상증착에 따른 손상 발생을 방지할 수 있다. 그에 따라 신뢰성이 높고 안정하며 높은 유전율을 갖는 Hf 실리케이트를 이용한 게이트 절연막을 형성할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

제1 원소, 산소 및 실리콘으로 이루어지는 실리케이트 형성 방법에 있어서,

반응챔버 내에 상기 제1 원소, 산소 및 실리콘 각각의 소스를 번갈아 주입하여 단원자층 증착법으로 웨이퍼 상에 실리케이트를 형성하는

실리케이트 형성 방법.

청구항 2.

제1 원소, 산소 및 실리콘으로 이루어지는 실리케이트 형성 방법에 있어서,

반응챔버 내에 웨이퍼를 주입하는 제1 단계;

상기 반응챔버 내에 제1 원소가 포함된 제1 소스를 주입하여 단위자층 증착법으로 상기 웨이퍼 상에 제1 원소층을 증착하는 제2 단계;

상기 반응챔버 내에 산소가 포함된 제2 소스를 주입하여 제1 원소와 산소의 화합물층을 형성하는 제3 단계; 및

상기 반응챔버 내에 실리콘이 포함된 제3 소스를 주입하여 제1 원소, 산소 및 실리콘의 화합물로 이루어지는 실리케이트를 형성하는 제4 단계

를 포함하는 실리케이트 형성 방법.

청구항 3.

제 2 항에 있어서,

상기 제2 단계 후,

상기 반응챔버 내에 불활성 가스를 주입하여 상기 반응챔버 내에 잔류하는 상기 제1 소스를 상기 불활성 가스와 함께 상기 반응챔버 밖으로 배출시키는 제5 단계를 더 포함하고,

상기 제3 단계 후,

상기 반응챔버 내에 불활성 가스를 주입하여 상기 반응챔버 내에 잔류하는 상기 제2 소스를 상기 불활성 가스와 함께 상기 반응챔버 밖으로 배출시키는 제6 단계를 더 포함하고,

상기 제4 단계 후,

상기 반응챔버 내에 불활성 가스를 주입하여 상기 반응챔버 내에 잔류하는 상기 제3 소스를 상기 불활성 가스와 함께 상기 반응챔버 밖으로 배출시키는 제7 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실리케이트 형성 방법.

청구항 4.

제 3 항에 있어서,

상기 제7 단계 후,

상기 제2 단계 내지 상기 제7 단계로 이루어지는 일련의 과정을 적어도 한번 더 실시하는 제8 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실리케이트 형성 방법.

청구항 5.

제 4 항에 있어서,

상기 제8 단계 후,

상기 실리케이트를 열처리하는 제9 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실리케이트 형성 방법.

청구항 6.

제 2 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제1 원소는,

Hf, Zr 또는 La 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 실리케이트 형성 방법.

청구항 7.

제 6 항에 있어서,

상기 제1 소스는,

HfCl_4 , 하프늄 테트라 - 부토사이드($\text{Hf}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$), ZrCl_4 , Zr 테트라 - 부타옥사이드($\text{Zr}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$), TaCl_5 , Ta 엔독시($\text{Ta}(\text{OC}_2\text{H}_5)_5$) 또는 LaCl_3 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 실리케이트 형성 방법.

청구항 8.

제 2 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제2 단계에서 HfCl_4 또는 하프늄 테트라 - 부토사이드($\text{Hf}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$)를 주입하여 상기 웨이퍼 상에 Hf층을 형성하고,

상기 제3 단계에서 H_2O 또는 O_3 , 자외선으로 여기된 O_2 또는 O_3 를 주입하여 상기 웨이퍼 상에 HfO_2 층 형성하고,

상기 제4 단계에서 SiH_4 , Si_2H_6 또는 SiCl_2H_2 를 주입하여 상기 웨이퍼 상에 Hf 실리케이트층을 형성하는 것을 특징으로 하는 실리케이트 형성 방법.

청구항 9.

제 8 항에 있어서,

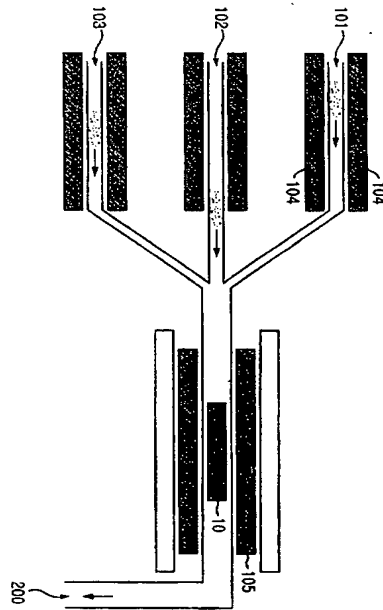
상기 제9 단계는,

자외선을 이용하여 300 °C 내지 500 °C 온도에서 O_2 또는 O_3 를 여기시켜 상기 실리케이트를 열처리하거나,

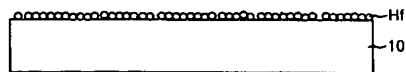
N_2O , O_2 또는 불활성 가스 분위기에서 500 °C 내지 1000 °C 온도로 급속열처리 또는 퍼니스 열처리하는 것을 특징으로 하는 실리케이트 형성 방법.

도면

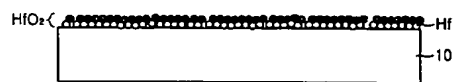
도면 1



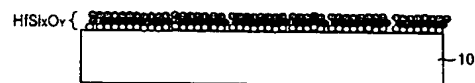
도면 2a



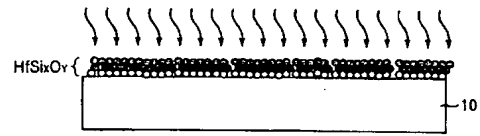
도면 2b



도면 2c



도면 2d



도면 3

